

# 2SJ261

PチャンネルMOS形シリコン電界効果トランジスタ  
超高速スイッチング用

新定規格

- 特長
- ・低オン抵抗。
  - ・超高速スイッチング。
  - ・低電圧駆動。

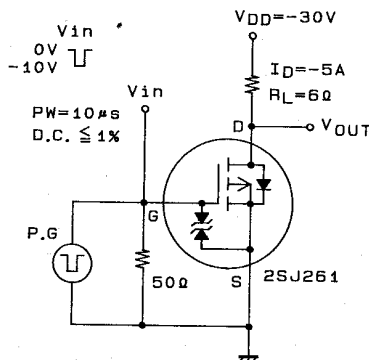
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25°C

			unit
ドレイン・ソース電圧	V <sub>DSS</sub>	-60	V
ゲート・ソース電圧	V <sub>GSS</sub>	±20	V
ドレイン電流 (DC)	I <sub>D</sub>	-10	A
ドレイン電流 (パルス)	I <sub>DP</sub>	PW ≤ 10μs, duty cycle ≤ 1%	A
許容損失	P <sub>D</sub>	Tc = 25°C	W
チャンネル温度	T <sub>ch</sub>	150	°C
保存周囲温度	T <sub>stg</sub>	-55 ~ +150	°C

電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25°C

			min	typ	max	unit
ドレイン・ソース降伏電圧	V <sub>(BR)DSS</sub>	I <sub>D</sub> = -1mA, V <sub>GS</sub> = 0	-60			V
ゲート・ソース降伏電圧	V <sub>(BR)GSS</sub>	I <sub>G</sub> = ±100μA, V <sub>DS</sub> = 0	±20			V
ドレイン・ソースしゃ断電流	I <sub>DSS</sub>	V <sub>DS</sub> = -60V, V <sub>GS</sub> = 0			-100	μA
ゲート・ソースもれ電流	I <sub>GSS</sub>	V <sub>GS</sub> = ±16V, V <sub>DS</sub> = 0			±10	μA
カットオフ電圧	V <sub>GS(off)</sub>	V <sub>DS</sub> = -10V, I <sub>D</sub> = -1mA	-1.0		-2.0	V
順伝達アドミタンス	Y <sub>fs</sub>	V <sub>DS</sub> = -10V, I <sub>D</sub> = -5A	4	7.5		S
飽和抵抗	R <sub>DS(on)</sub>	I <sub>D</sub> = -5A, V <sub>GS</sub> = -10V		0.11	0.15	Ω
	R <sub>DS(on)</sub>	I <sub>D</sub> = -5A, V <sub>GS</sub> = -4V		0.15	0.2	Ω
入力容量	C <sub>iss</sub>	V <sub>DS</sub> = -20V, f = 1MHz		1230		pF
出力容量	C <sub>oss</sub>	V <sub>DS</sub> = -20V, f = 1MHz		390		pF
帰還容量	C <sub>rss</sub>	V <sub>DS</sub> = -20V, f = 1MHz		100		pF
ターンオン遅延時間	t <sub>d(on)</sub>	下図指定回路において		16		ns
立上り時間	t <sub>r</sub>	"		40		ns
ターンオフ遅延時間	t <sub>d(off)</sub>	"		230		ns
下降時間	t <sub>f</sub>	"		150		ns
ダイオード順電圧	V <sub>SD</sub>	I <sub>S</sub> = -10A, V <sub>GS</sub> = 0	-1.0	-1.5		V

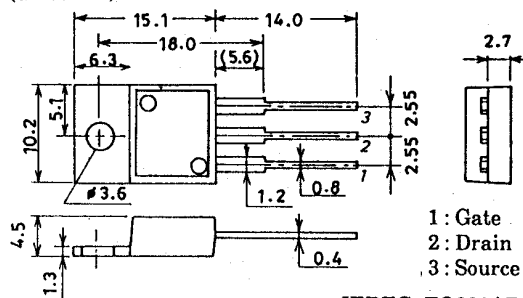
スイッチングタイム測定回路



A04855

本製品は開発中です。  
詳細については営業担当者にご連絡ください。

外形図 2052C  
(unit: mm)



1: Gate  
2: Drain  
3: Source

JEDEC: TO220AB  
EIAJ : SC46